



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110124004
2011 年 2 月 1 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HVAL-SLL LBC3Sプロセス 一部製品 前処理サイト追加予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての一次予定の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、変更前の製品サンプル作製は行わない為、変更品評価用サンプルご入用の場合には、事前に本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。変更時期につきましては、次頁以降の変更時期をご参照下さい。お客様の受領連絡及びサンプル依頼は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☒ Initial notice (Plan) ☐ Final notice
変更概要	☒ Design/Specification ☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab ☒ Site ☐ Process ☐ Material
	☐ Wafer Bump ☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☐ Assembly ☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☐ Test ☐ Site ☐ Process
	☐ Others ☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	HVAL-SLL LBC3S プロセス 一部製品 前処理サイト追加 現行 : TI-Sherman (米国) 変更後 : TI-Sherman (米国), TI-Hi ji (日本)
対象製品	対象製品リスト参照
変更時期	5月上旬の出荷より予定しています。
品質認定試験	☒ 計画 ☐ 終了
製品表示	☐ 変更無し ☒ 変更あり
備考	—

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。
最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、認定試験の結果を含め、本PCNの更新版の発行をもって連絡させていただきます。

弊社 HVAL-SLL (汎用リニアロジック) LBC3S プロセス 一部製品の 前処理サイトについて、現行 TI-Sherman (米国) サイトにて製造しておりますが、供給能力確保の為に、これに加えて、TI-Hi ji (日本) サイトを追加する予定です。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

前処理サイト

現行

TI-Sherman (米国)

変更後

TI-Sherman (米国)

TI-Hi ji (日本)

理由：供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
CD3301RHHR	MAX232NSRE4	MAX3232IDW	MAX3243IDWG4	TRS3232CDRG4
HPA00699CDBR	MAX232NSRG4	MAX3232IDWE4	MAX3243IDWR	TRS3232CDWR
MAX232D	MAX3232CD	MAX3232IDWG4	MAX3243IDWRE4	TRS3232CDWRG4
MAX232DE4	MAX3232CDB	MAX3232IDWR	MAX3243IDWRG4	TRS3232CPW
MAX232DG4	MAX3232CDBE4	MAX3232IDWRE4	MAX3243IPW	TRS3232CPWG4
MAX232DR	MAX3232CDBG4	MAX3232IDWRG4	MAX3243IPWG4	TRS3232IDR
MAX232DRE4	MAX3232CDBR	MAX3232IPW	MAX3243IPWR	TRS3232IDRG4
MAX232DRG4	MAX3232CDBRE4	MAX3232IPWE4	MAX3243IPWRE4	TRS3232IPW
MAX232DW	MAX3232CDBRG4	MAX3232IPWG4	MAX3243IPWRG4	TRS3232IPWG4
MAX232DW-C	MAX3232CDE4	MAX3232IPWR	TRS232D	TRS3232IPWR
MAX232DWE4	MAX3232CDG4	MAX3232IPWRE4	TRS232DG4	TRS3232IPWRG4
MAX232DWG4	MAX3232CDR	MAX3232IPWRG4	TRS232DR	TRS3243CDB
MAX232DWR	MAX3232CDRE4	MAX3243CDB	TRS232DRG4	TRS3243CDBG4
MAX232DWR-C	MAX3232CDRG4	MAX3243CDBE4	TRS232DW	TRS3243CDBR
MAX232DWRE4	MAX3232CDW	MAX3243CDBG4	TRS232DWG4	TRS3243CDBRG4
MAX232DWRG4	MAX3232CDWG4	MAX3243CDBR	TRS232DWR	TRS3243CDW
MAX232ID	MAX3232CDWR	MAX3243CDBRE4	TRS232DWRG4	TRS3243CDWG4
MAX232IDE4	MAX3232CDWRG4	MAX3243CDBRG4	TRS232ID	TRS3243CDWR
MAX232IDG4	MAX3232CPW	MAX3243CDW	TRS232IDG4	TRS3243CDWRG4
MAX232IDR	MAX3232CPWE4	MAX3243CDWE4	TRS232IDR	TRS3243CPW
MAX232IDRE4	MAX3232CPWG4	MAX3243CDWG4	TRS232IDRG4	TRS3243CPWG4
MAX232IDRG4	MAX3232CPWR	MAX3243CDWR	TRS232IDW	TRS3243CPWR

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

MAX2321DW	MAX3232CPWRE4	MAX3243CDWRG4	TRS2321DWG4	TRS3243CPWRG4
MAX2321DWE4	MAX3232CPWRG4	MAX3243CPW	TRS2321DWR	TRS3243IDB
MAX2321DWG4	MAX32321D	MAX3243CPWE4	TRS2321DWRG4	TRS3243IDBG4
MAX2321DWR	MAX32321DB	MAX3243CPWG4	TRS2321N	TRS3243IDBR
MAX2321DWRE4	MAX32321DBE4	MAX3243CPWR	TRS2321NE4	TRS3243IDBRG4
MAX2321DWRG4	MAX32321DBG4	MAX3243CPWRE4	TRS232N	TRS3243IDW
MAX2321N	MAX32321DBR	MAX3243CPWRG4	TRS232NE4	TRS3243IDWG4
MAX2321NE4	MAX32321DBRE4	MAX32431DB	TRS232NS	TRS3243IDWR
MAX232N	MAX32321DBRG4	MAX32431DBE4	TRS232NSG4	TRS3243IDWRG4
MAX232NE4	MAX32321DE4	MAX32431DBG4	TRS232NSR	TRS3243IPW
MAX232NS	MAX32321DG4	MAX32431DBR	TRS232NSRG4	TRS3243IPWG4
MAX232NSE4	MAX32321DR	MAX32431DBRE4	TRS3232CDBR	TRS3243IPWR
MAX232NSG4	MAX32321DRE4	MAX32431DBRG4	TRS3232CDBRG4	TRS3243IPWRG4
MAX232NSR	MAX32321DRG4	MAX32431DW	TRS3232CDR	

製品表示

この変更に伴い、出荷ラベルに記載のサイト記号(ラベルの"20L/21L"の箇所)及びラベル上の表示位置は、下記のようになる予定です。

	現行	追加認定
Fab Site: 前処理サイト	TI-Sherman	TI-Hiji
CSO (20L): 前処理サイトコード	SHE	HIJ
CCO (21L): 生産国記号	USA	JPN



図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2010年11月	終了	2011年1月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	CD3301RHHR	-	-	
Wafer Fab Site:	HIJ	Wafer Fab Process:	LBC3S	
Wafer diameter(mm):	150	Metallization:	7600A Al-Cu(0.5%) on 3000A TiW	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp Operating Life	150C, 300 Hrs	77	77	77
Electrical Characterization	-	30	30	30
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77	77	77
ESD MM	Per JEDEC	3	3	3
ESD CDM	Per JEDEC	3	3	3
ESD HBM	Per JEDEC	3	3	3
Latch-up	per JESD78	6	6	6
Note: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-3/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2010 年 11 月	終了	2011 年 1 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	MAX232N	-	-	
Wafer Fab Site:	HIJ	Wafer Fab Process:	LBC3S	
Wafer diameter(mm):	150	Metallization:	7600A Al-Cu(0.5%) on 3000A TiW	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
High Temp Operating Life	150C, 300 Hrs	77	77	77
Electrical Characterization	-	30	30	30
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77	77	77
ESD MM	Per JEDEC	3	3	3
ESD CDM	Per JEDEC	3	3	3
ESD HBM	Per JEDEC	3	3	3
Latch-up	per JESD78	6	6	6

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2010 年 11 月	終了	2011 年 1 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	MAX3232CDB	-	-	
Wafer Fab Site:	HIJ	Wafer Fab Process:	LBC3S	
Wafer diameter(mm):	150	Metallization:	7600A Al-Cu(0.5%) on 3000A TiW	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp Operating Life	150C, 300 Hrs	77	77	77
Electrical Characterization	-	30	30	30
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77	77	77
ESD MM	Per JEDEC	3	3	3
ESD CDM	Per JEDEC	3	3	3
ESD HBM	Per JEDEC	3	3	3
Latch-up	per JESD78	6	6	6
Note: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2010 年 11 月	終了	2011 年 1 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	MAX3243CDBR	-	-	
Wafer Fab Site:	HIJ	Metallization:	7600A Al-Cu(0.5%) on 3000A TiW	
Wafer Fab Process:	LBC3S	Wafer diameter(mm):	150	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp Operating Life	150C, 300 Hrs	77	77	77
Electrical Characterization	-	30	30	30
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77	77	77
ESD MM	Per JEDEC	3	3	3
ESD CDM	Per JEDEC	3	3	3
ESD HBM	Per JEDEC	3	3	3
Latch-up	per JESD78	6	6	6
Note: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-1/260C				